



SVD1N60P

NPN

主要用途:

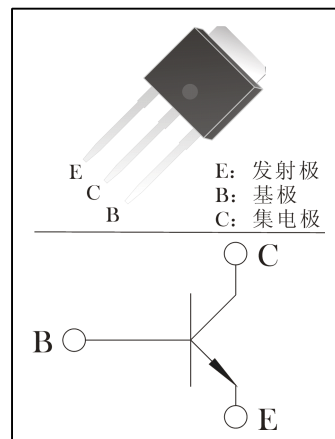
电子镇流器、节能灯、充电器及各类功率开关电路。

主要特点:

耐压高、开关速度快、安全工作区大、输出特性好、电流容量大。

封装形式:

T0-251



极限值 (TC=25℃)

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-发射极击穿电压	BVce0	≥ 480	V
集电极-基极击穿电压	BVcb0	≥ 700	V
发射极-基极击穿电压	BVeb0	≥ 9	V
最大集电极直流电流	Icm	1.2	A
最大耗散功率	Pc	20	W
最高工作温度	Tj	150	℃
贮存温度	Tstg	-55~150	℃

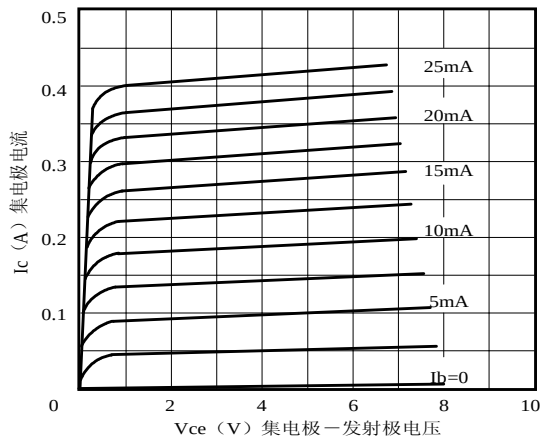
电特性 (TC=25℃)

参数名称	符号	测试条件	额定值		单位
			最小值	最大值	
集电极-发射极击穿电压	BVce0	Ic=1mA IB=0	480		V
集电极-基极击穿电压	BVcb0	Ic=1mA IE=0	700		V
发射极-基极击穿电压	BVeb0	IE=1mA IC=0	9		V
集电极-发射极反向漏电流	Ice0	Vce=400V IB=0		20	uA
集电极-发射极反向漏电流	Icb0	Vcb=680V IE=0		10	uA
发射极-基极反向漏电流	Ieb0	Veb=7V IC=0		10	uA
共发射极直流电流增益	Hfe	Vce=5V Ic=0.2A	10	35	
		Vce=5V Ic=1mA	8		
集电极-发射极饱和压降	Vcesat	Ic=0.5A Ib=0.2A		0.6	
存储时间	Ts	Ic=250mA	2.0	3.0	uS
特征频率	fT	Vce=10V Ic=0.1A f=1MHz	8		MHZ

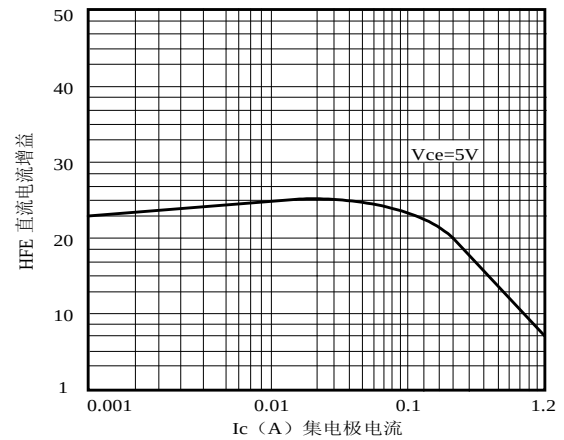


特性曲线

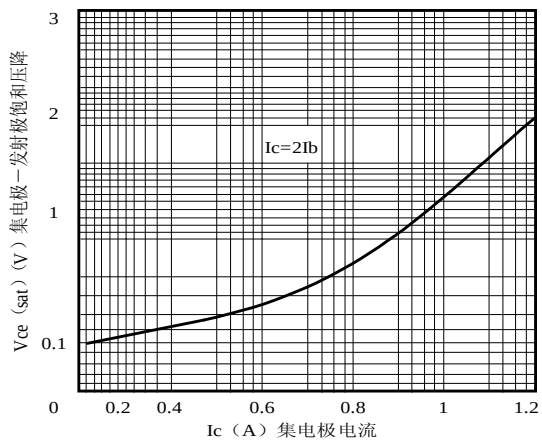
静态输出特性



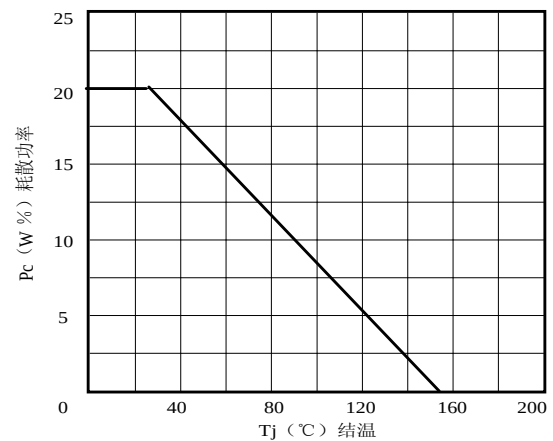
HFE 直流电流增益— I_c 集电极电流



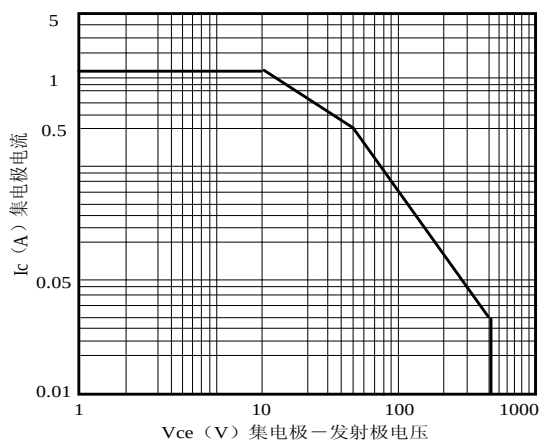
$V_{ce(sat)}$ 集电极-发射极饱和压降— I_c 集电极电流



P_c 耗散功率— T_j 结温



SOA (DC) 安全工作区





产品尺寸

TO-251

